

## 7A、600V N沟道增强型场效应管

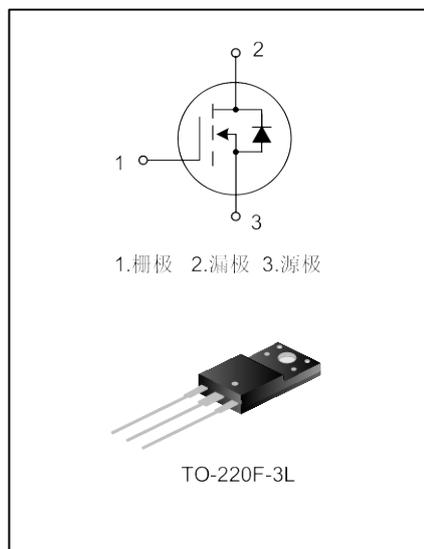
### 描述

SVF7N60EF N沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

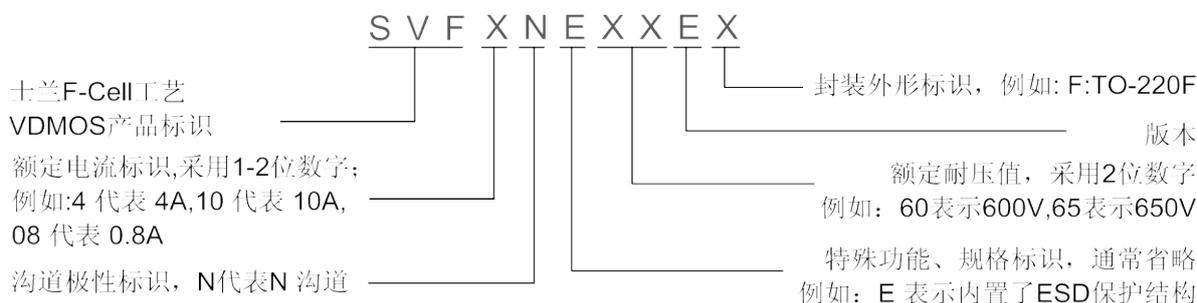
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

### 特点

- \* 7A, 600V,  $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.96\Omega @ V_{GS}=10V$
- \* 低栅极电荷量
- \* 低反向传输电容
- \* 开关速度快
- \* 提升了 dv/dt 能力



### 命名规则



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SVF7N60EF	TO-220F-3L	SVF7N60EF	无铅	料管

**极限参数**(除非特殊说明,  $T_C=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	参数范围	单位
漏源电压	$V_{DS}$	600	V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$	V
漏极电流	$I_D$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	7.0
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	4.0
漏极冲击电流	$I_{DM}$	28	A
耗散功率 ( $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ) - 大于 $25^{\circ}\text{C}$ 每摄氏度减少	$P_D$	45	W
		0.36	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	$E_{AS}$	489	mJ
工作结温范围	$T_J$	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	$T_{stg}$	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

**热阻特性**

参数名称	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.78	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	120	$^{\circ}\text{C/W}$

**电性参数**(除非特殊说明,  $T_C=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$B_{VDSS}$	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	600	--	--	V
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	$\mu\text{A}$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	$\pm 100$	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=3.5\text{A}$	--	0.96	1.2	$\Omega$
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V},$ $f=1.0\text{MHz}$	--	1026.00	--	pF
输出电容	$C_{oss}$		--	108.20	--	
反向传输电容	$C_{rss}$		--	4.59	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300\text{V}, I_D=7.0\text{A},$ $R_G=25\Omega$ (注 2,3)	--	21.87	--	ns
开启上升时间	$t_r$		--	35.87	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	62.13	--	
关断下降时间	$t_f$		--	36.00	--	
栅极电荷量	$Q_g$	$V_{DS}=480\text{V}, I_D=7.0\text{A},$ $V_{GS}=10\text{V}$ (注 2,3)	--	20.70	--	nC
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$		--	6.05	--	
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$		--	7.60	--	

**源-漏二极管特性参数**

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	$I_S$	MOS 管中源极、漏极构成的	--	--	7.0	A
源极脉冲电流	$I_{SM}$	反偏 P-N 结	--	--	28	
源-漏二极管压降	$V_{SD}$	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	$T_{rr}$	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V,$ $di_f/dt=100A/\mu s$	--	471	--	ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$		--	3.43	--	$\mu C$

**注:**

1.  $L=30mH, I_{AS}=5.16A, V_{DD}=159V, R_G=25\Omega$ , 开始温度  $T_J=25^\circ C$ ;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
3. 基本不受工作温度的影响。

**典型特性曲线**

图1. 输出特性

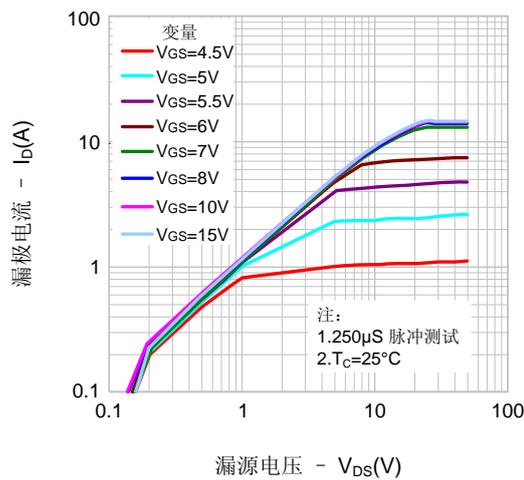


图2. 传输特性

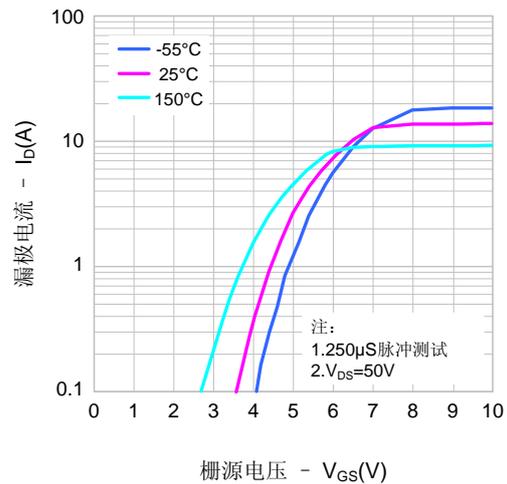


图3. 导通电阻 vs. 漏极电流

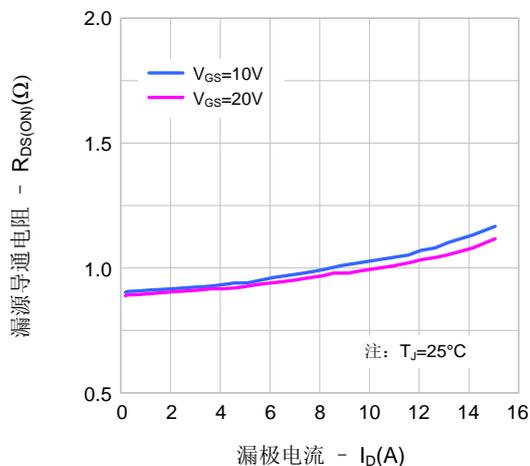
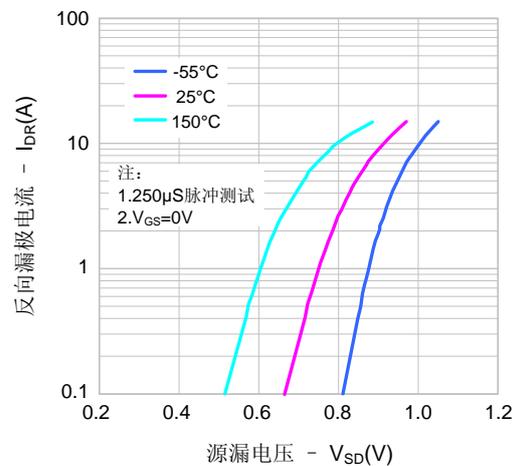


图4. 体二极管正向压降 vs. 源极电流、温度



典型特性曲线 (续)

图5. 电容特性

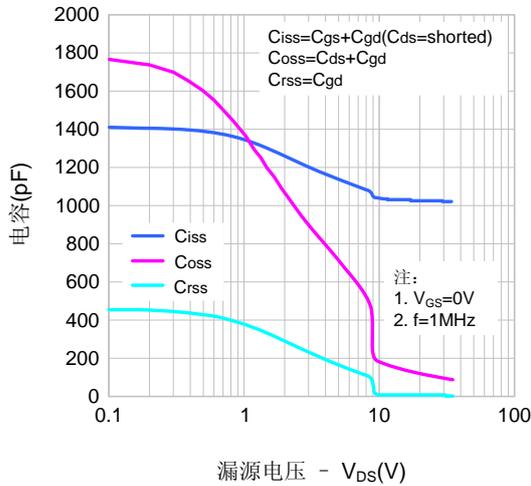


图6. 电荷量特性

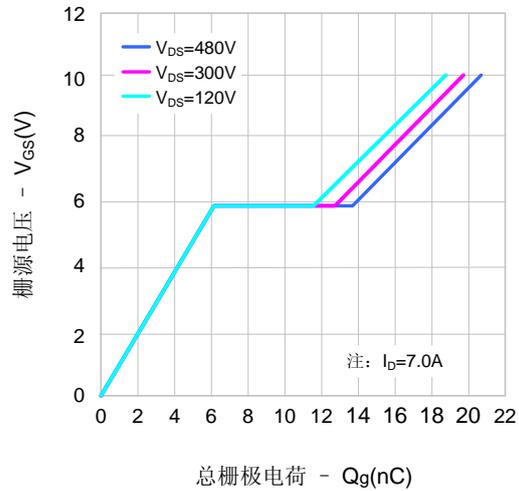


图7. 击穿电压vs.温度特性

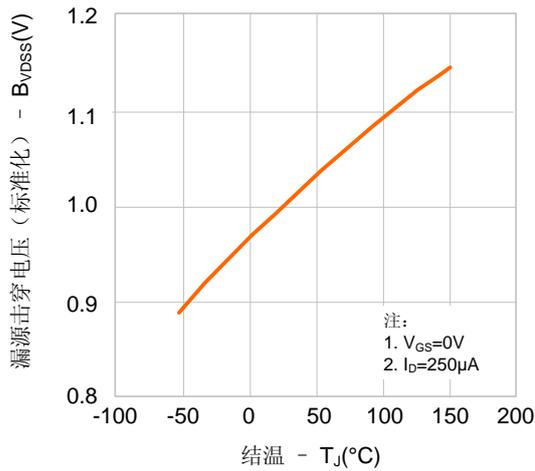


图8. 导通电阻vs.温度特性

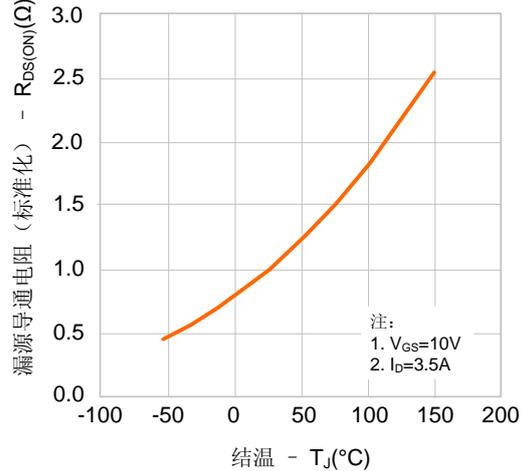


图9. 最大安全工作区域

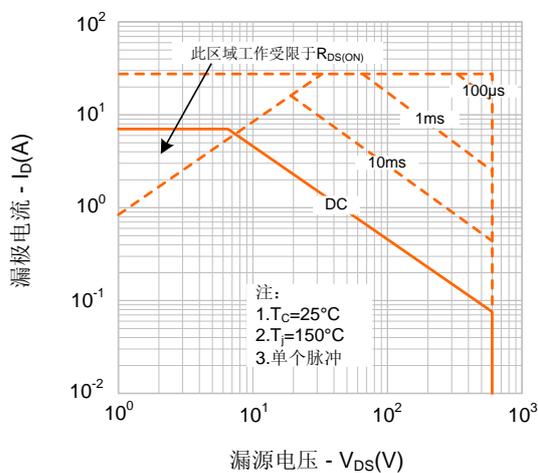
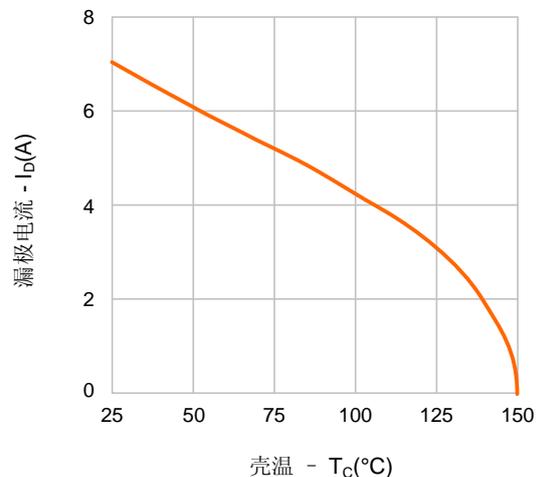
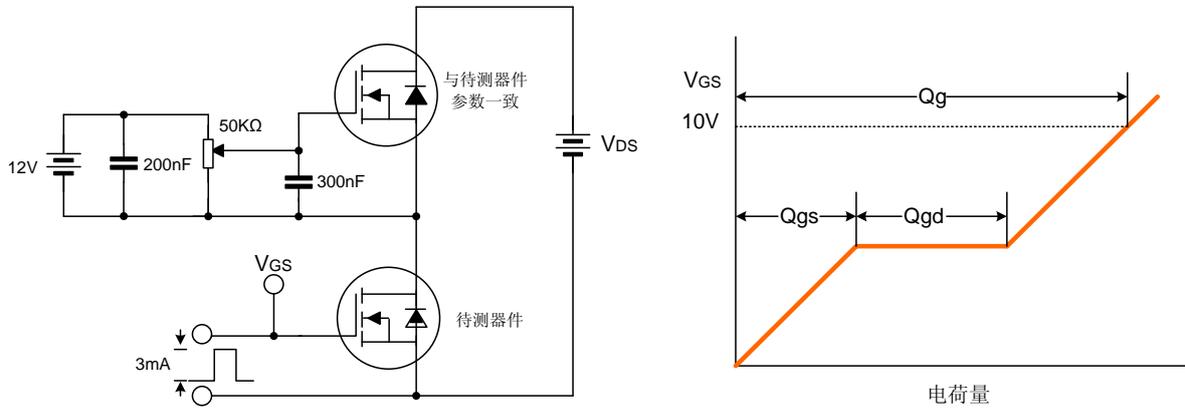


图10. 最大漏电流vs. 壳温

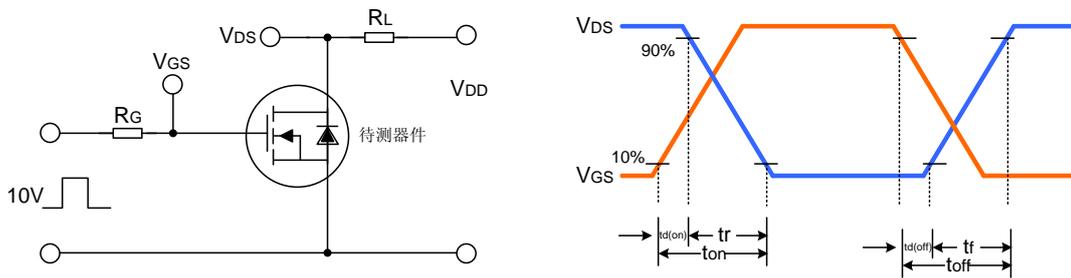


典型测试电路

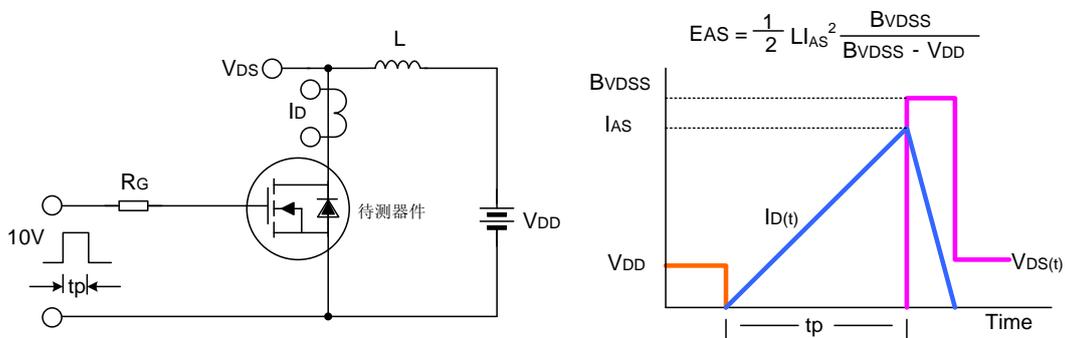
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图





附:

修改记录:

日期	版本号	描述	页码
2012.10.26	1.0	原版	